



Toshiba élargit sa gamme de MOSFET "trench" dernière-génération, avec un dispositif 40V ultra-compact pour circuits à faible EMI

Le MOSFET canal-N U-MOS-IX-H à diode SRD intégrée, est parfait pour les alimentations et les commandes moteurs

Düsseldorf, Allemagne, 14 novembre 2017 – Toshiba Electronics Europe élargit sa gamme de MOSFET basés sur son procédé semiconducteurs "trench" de dernière génération, U-MOS-IX-H, avec un nouveau dispositif 40V ultra-compact à diode SRD (Soft Recovery Diode, ou diode de récupération) intégrée.

Grâce à sa diode SRD intégrée, le TPH1R204PB est en mesure de maintenir à un niveau minimum les pics de tension générés entre drain et source lors de la commutation. Ce MOSFET est ainsi adapté au redressement synchrone au secondaire des alimentations à découpage qui nécessitent un faible niveau EMI (Electro Magnetic Interference, ou parasite électromagnétique). Les applications cibles sont notamment les convertisseurs AC-DC et DC-DC haut-rendement, ainsi que les commandes moteurs, par exemple pour les outils électroportatifs sans fil.

Le TPH1R204PB est un dispositif canal-N avec une résistance à l'état passant ($R_{DS(ON)}$) maximum de seulement 1.2 m Ω ($V_{GS} = 10V$). La charge nominale en sortie (Q_{OSS}) n'est que de 56 nC. Ce dispositif est conditionné en boîtier SOP Advance de seulement 5 x 6 x 0,95 mm.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Press Release

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

Fondé en 1973 à Neuss en Allemagne, TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Akira Morinaga. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tél : +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail : discrete-ic@toshiba-components.com

Pour des informations concernant la publication, contactez :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tél : +44 (0) 282 2832

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par :

Birgit Schöniger, Publitek

Tél : +44 (0) 20 8429 6554

Web : www.publitek.com

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com

Novembre 2017

Réf : 7080/A